文档版本	V1. 0. 0
发布日期	20221026

APT32F110x 基于 CSI 库 IFC 应用指南

,',|?7'



目录

1	概述	1
2.	适用的硬件	1
3.	应用方案代码说明	1
	3.1 IFC 模块介绍	1
	3.2 IFC 写数据	2
	3.3 IFC 读数据	3
4.	程序下载和运行	4

1 概述

本文介绍了在APT32F110x中使用IFC的应用范例。

2. 适用的硬件

该例程使用于 APT32F110x 系列学习板

3. 应用方案代码说明

基于 APT32F110x 完整的库文件系统,可以对 IFC 进行配置。

3.1 IFC 模块介绍

APT32F110x 系列片上带有 64K/32K 字节的闪存(PROM),支持通过 ISP 来更新闪存内容。 芯片上电后,CPU 从 PROM 取指令并且执行。APT32F110X 系列还支持额外的数据闪存(DROM) 存储空间,让用户在掉电之前存储一些应用程序需要的数据。

● 主要特性:

- 1) 程序闪存(PROM)大小: 64K/32K Bytes
- 2) 数据闪存(DROM)大小: 2K Bytes
- 3) 编程支持 ISP 模式和专用的工具模式
- 4) 页大小: 256 Bytes (PROM), 64 Bytes (DROM)
- 5) 可擦除单元:页
- 6) 可靠性: PROM 和 DROM 都为 100,000 次
- 7) 可自定义的选项(称为 User Option) 支持 iWDT 使能和禁止, 配置复位管脚
- 8) 支持各种保护:调试接口保护,硬件保护和读保护
- 硬件配置:

APT32F110x 系列闪存由程序存储单元(PROM),数据存储单元(DROM),用户配置单元(User

Option),保护选项和客户信息区域构成。PROM 有 256/128 个页空间,每页有 256 字节。 最小的擦除和烧写单元为页空间,用户只可以对整个页空间进行擦除或者烧写,不能擦除 或者烧写某个指定的字节(Word)。

● 注意事项:

1. 写数据时, 起始地址必须是 4 的倍数

 2. 在同一页中写数据时,若起始地址并非该页的开始地址,则该地址前面的数据会被擦除 掉

3. 写闪存操作不要使用并行模式

4. 闪存控制器支持最大 16MHz 系统频率下的 0-wait 读取。当频率超过 16MHz 时,

CPU 读取闪存时需要增加额外的等待周期。不同的 CPU 频率下,WAIT 和 SPEED 的值参考如下。

	WAIT	SPEED
24MHz < SYSCLK ≤ 48MHz	2	1
16MHz < SYSCLK ≤ 24MHz	1	1
SYSCLK ≤ 16MHz	0	0

图 3.1.1 等待周期

3.2 IFC 写数据

选择内部主频 48MHz 作为系统时钟,可在 user_demo.c 文件中 ifc_program ()函数进行配置。从 0xfe78 地址(PROM)开始,写入 3 个 word 数据;从 0x10000078 地址(DROM)开始,写入 5 个 word 数据。

void ifc_program(void)
{ csi_error_t tRet;
tRet = csi_ifc_program(IFC, 0xfef8, wWriteData, 3);
if (tRet == CSI_ERROR)
my_printf("program fail!\n");
else
my_printf("program pass!\n");
tRet = csi_ifc_program(IFC, 0x10000078, wWriteData, 5);
if (tRet == CSI_ERROR)

```
my_printf("program fail!\n");
else
my_printf("program pass!\n");
}
```

● 代码说明:

csi_ifc_program(): ---- 往 Flash 区域写入内容, 带校验功能。支持 PFLASH 和 DFLASH。

● 函数参数说明:

csi_ifc_program(csp_ifc_t *ptlfcBase, uint32_t wAddr, uint32_t *pwData, uint32_t

wDataNum);

ptIfcBase: 指向IFC控制寄存器结构体的指针,用于进行寄存器操作

wAddr:操作Flash的目标首址

pwData:指向需要写入数据的首地址

wDataNum:写入数据的长度,以 word 为单位。

● 数据验证:

	vA	100	000000										
	0x1000058 0x000		0000	0x0000	00000	0x0000	00000	0x0000	00000	0x00000	000		
	0x10000078 0xcdcd		leded 0x23232323		32323	0x45454545		0x67676767		0x89898989			
	0x10000098		0x0000	00x00 0x00		00000	0000x0 0000		0x00000000		0x00000000		
图 3.2.1 DROM 写入数据													
	0x0000fee8		0x00000000		0x00000000		0x000000x0		0x00000000				
	0x0000fef8		Oxedededed		0x23232323		0x45454545		0x0000000				
	0x0000ff08		0x000000x0		0x000000x0		0x00000000		0x0000000				
	0x0000ff18 0x00000		00000	0x000	00000	0x000	00000	0x000	00000				

图 3.2.2 PROM 写入数据

3.3 IFC 读数据

选择内部主频 48MHz 作为系统时钟,可在 user_demo.c 文件中 ifc_read()函数进行配置。 从 0x10000078 地址(DR0M)开始,读出 5 个 word 数据。

```
void ifc_read(void)
{
    csi_ifc_read(IFC,0x10000078, wReadBuf, 5);
    my_printf("read flash data: 0x%x, 0x%x \n", wReadBuf[0], wReadBuf[1]);
```

● 代码说明:

ifc_read(): ----- 读取 Flash 区域的内容,支持 DROM 和 PROM。

● 函数参数说明:

csi_ifc_read(csp_ifc_t *ptlfcBase,uint32_t wAddr,uint32_t *wData, uint32_t wDataNum);

ptlfcBase: 指向IFC控制寄存器结构体的指针,用于进行寄存器操作。

wAddr:读取 Flash 数据的首地址。

wData:指向目标数据首地址指针。

wDataNum:读取数据长度。

● 数据验证:

Expression	Value	Туре
□ wReadBuf	[10]	uint32_t [10]
0	0xcdcdcdcd	uint32_t
1	0x23232323	uint32_t
2	0x45454545	uint32_t
3	0x67676767	uint32_t
4	0x89898989	uint32_t
5	0x0000000	uint32_t
6	0x0000000	uint32_t
7	0x0000000	uint32_t
8	0x0000000	uint32_t
9	0x0000000	uint32_t

图 3.3.1 IFC 读取数据

4. 程序下载和运行

- 1. 将目标板与仿真器连接,分别为 VDD、SCLK、SWIO、GND。
- 2. 程序编译后仿真运行。
- 3. 可在 CDK 的 Debug 模式下查看数据是否正确, 例如图 3.2.1、图 3.2.2、图 3.3.1 所示。。